



تحلیل ارتعاشات نانوصفحه‌های دایره‌ای تحت تحریک الکترواستاتیکی غیرخطی با لحاظ اثرات سطح و اندازه

مهرداد شیخلو^{۱*}، سید علی دلبری^۲، عباس صباحی نمینی^۱، آرش عبدالملکی^۳

^۱ استادیار، گروه علوم مهندسی، دانشکده فن آوری‌های نوین، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

^۲ مربی، گروه علوم مهندسی، دانشکده فن آوری‌های نوین، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

^۳ استادیار، گروه بیوانفورماتیک، دانشکده فن آوری‌های نوین، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

تاریخ دریافت: ۱۴۰۰/۱۱/۱۰؛ تاریخ بازنگری: ۱۴۰۱/۰۶/۲۵؛ تاریخ پذیرش: ۱۴۰۱/۰۹/۲۲

چکیده

در این مقاله رفتار رزونانس اصلی و ناپایداری پولین استاتیکی نانوصفحه دایره‌ای با تحریک الکترواستاتیکی غیرخطی بررسی شده است. معادله حاکم بر رفتار نانوصفحه کر شهف با در نظر گرفتن نیروی میرایی سیال و نیروی کز میر و استفاده از تئوری تنش کوپل سازگار و تئوری سطح گورتین-مورداک و اصل همپلتون استخراج شده است. معادله حاکم برای ارتعاشات با دامنه کوچک حل شده است. برای این منظور، فرض شده که ابتدا صفحه توسط یک ولتاژ پایه DC خم می‌شود و سپس، به وسیله یک ولتاژ هارمونیک AC تحریک می‌شود تا حول حالت تعادل استاتیکی نوسان کند. برای به دست آوردن مدل کاهش مرتبه یافته از روش مانده های وزنی گالرکین استفاده شده است. با استفاده از روش مقیاس‌های چند گانه برای معادله غیرخطی حل نیمه تحلیلی ارائه شده و معادله پاسخ فرکانسی سیستم برای حالت رزونانس اصلی استخراج شده است. تاثیر لحاظ کردن اثرات اندازه و سطح بر روی ولتاژ پولین استاتیکی و پاسخ فرکانسی رزونانس اصلی سیستم بررسی شده است. نتایج عددی به دست آمده با نتایج تحقیقات قبلی مقایسه و مطابقت خوبی بین آنها مشاهده شد. نشان داده شد که تحریک الکترواستاتیکی و نیروی کز میر اثر نرم‌شوندگی دارند، در حالی که اثرات سطحی بسته به خواص مکانیکی سطح، ابعاد و شرایط مرزی نانوصفحه می‌تواند اثر سخت‌شوندگی یا نرم‌شوندگی داشته باشد.

کلمات کلیدی: نانوصفحه دایره‌ای؛ پارامتر مقیاس طول؛ رزونانس اصلی؛ اثرات انرژی سطحی.

Vibration Analysis of Circular Nanoplates under Nonlinear Electrostatic Excitation Considering the Surface Energy and Size Effects

M. Sheikhlou^{1,*}, S.A. Delbari², A. Sabahi namini¹, A. Abdolmaleki³

¹ Assis. Prof., Faculty of Advanced Technologies, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.

² M.Sc. Faculty of Advanced Technologies, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.

³ Assis. Prof., Faculty of Advanced Technologies, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.

Abstract

This article investigates the primary resonant behavior and static pull-in instability of a circular nanoplate under nonlinear electrostatic actuation. The consistent couple stress theory, Gurtin-Murdoch surface elasticity theory and Hamilton principle were utilized to derive the governing differential equation of transverse vibration Kirchhoff nanoplate by considering the fluid damping and Casimir forces. The governing equation were solved for small amplitude vibrations. To this end, it is assumed that the elastic nanoplate is deflected using a DC bias voltage and then driven to vibrate around its deflected position by a harmonic AC load. The weighted residual method of Galerkin was used to obtain a reduced order model. The method of multiple scales is used to solve the nonlinear equation of motion and, the primary resonance mode frequency response equation is derived. The obtained numerical results were compared to those of previous research works, and a good agreement observed between them. The numerical results revealed that electrostatic actuation and Casimir force have softening effects; but the surface energy can has hardening or softening effect depending on the surface mechanical properties, dimensions and boundary conditions of the nanoplate.

Keywords: Circular nanoplate; Material length scale parameter; Primary resonance; Surface energy effects.

۱- مقدمه

نتایج آزمایشگاهی نشان می‌دهند که در مقیاس میکرو و نانو رفتار ساختارها وابسته به اندازه است [۱]؛ بنابراین، برای آنالیز نانو ساختارها باید اندازه در نظر گرفته بشوند [۲]. با توجه به این که انجام آزمایش‌های کنترل شده در مقیاس نانو سخت است و شبیه‌سازی‌های دینامیک مولکولی نیز از لحاظ محاسباتی بسیار پرهزینه هستند، مدل‌سازی نانو ساختارها با استفاده از تئوری مکانیک محیط‌های پیوسته مورد توجه پژوهشگران زیادی قرار گرفته است [۳]. در مکانیک محیط‌های پیوسته‌ی کلاسیک اثرات اندازه لحاظ نشده است؛ بنابراین تئوری‌های اصلاح شده مختلفی توسعه پیدا کرده‌اند تا بر این کاستی غلبه کنند. تئوری نرخ کرنش، تئوری تنش کوپل، تئوری میکروپلار و تئوری الاستیسیته‌ی غیر موضعی تئوری‌های محیط پیوسته اصلاح شده‌ای هستند که اثرات اندازه را لحاظ می‌کنند [۴]. تئوری تنش کوپل کلاسیک توسط توپین [۵]، میندلین و تیرستن [۶] و کوتیر [۷] توسعه پیدا کرد. تئوری تنش کوپل کلاسیک شامل چهار ثابت مربوط به ماده‌ی سازنده‌ی ریز ساختار است (دو ثابت کلاسیک و دو ثابت اضافه). محاسبه‌ی ثابت‌های افزون بر ثابت‌های لانه در تئوری‌های الاستیسیته‌ی غیر کلاسیک کار پیچیده‌ای است. حاج اسفندیاری و درگوش [۸] مدلی از تئوری تنش کوپل ارائه کردند که در آن به دلیل صرف نظر کردن از مولفه‌های نرمال تانسور تنش کوپلی در یک المان حجم از محیط پیوسته، تانسور تنش کوپل پادمتقارن است و به این دلیل از بخش متقارن تنش کوپل صرف‌نظر می‌شود. معادلات ساختاری توسعه یافته توسط این مدل تنها شامل یک پارامتر مقیاس طول می‌باشند. این مدل به عنوان تئوری تنش کوپل سازگار شناخته می‌شود. آقابابایی بنی و همکاران [۹] با استفاده از تئوری تنش کوپل سازگار پاسخ دینامیکی وابسته به اندازه یک میکروصفحه مستطیلی در مجاورت فیلم سیال مطالعه کردند. اکبری الشتی و ابوالقاسمی [۱۰] برای مطالعه ارتعاشات آزاد میکرو تیرهای اویلر-برنولی از تئوری کوپل تنش سازگار استفاده کردند.

یانگ و همکارانش [۱۱] با اصلاح تئوری تنش کوپل کلاسیک با وارد کردن یک رابطه‌ی تعادل اضافی حاکم بر رفتار کوپل‌ها، تئوری تنش کوپل اصلاح شده را ارائه نمودند. در این تئوری، تانسور تنش کوپل به یک تانسور متقارن تبدیل شده و

پارامترهای مقیاس اندازه‌ی ماده‌ی سازنده‌ی ریزساختار تنها به یک پارامتر مقیاس طول کاهش می‌یابد. این ویژگی استفاده از تئوری تنش کوپل اصلاح شده را آسانتر می‌کند. از تئوری تنش کوپل اصلاح شده برای محاسبه اثرات اندازه در مدل میکرو تیر اویلر-برنولی [۱۲]، مدل میکرو تیر تیموشنکو [۱۳]، مدل میکرو صفحه کرشلف [۱۴]، مدل میکرو صفحه میندلین [۱۵] و مدل میکرو صفحه ردی [۱۶] مورد استفاده قرار گرفته است.

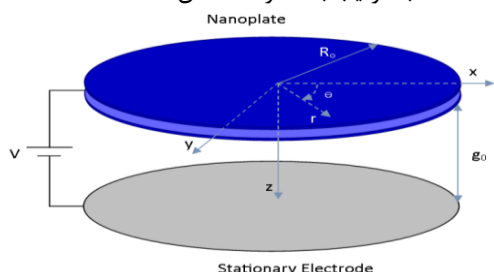
انرژی سطحی مربوط به چند لایه از اتم‌های نزدیک به سطح است و در مقیاس ماکرو نسبت حجم اتم‌های نزدیک سطح به حجم کل ماده خیلی کوچک است. لذا، نسبت انرژی سطحی به انرژی کل ماده خیلی ناچیز است و بنابراین در تئوری الاستیسیته کلاسیک اثرات سطح در نظر گرفته نمی‌شود. کاهش اندازه ساختارها به میکرو و نانو باعث می‌شود که نسبت انرژی سطحی به کل انرژی ماده افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا کند [۱۷]، بنابراین باید برای مطالعه ریزساختارها اثرات سطح نیز لحاظ شود. گورتین و مورداک [۱۸، ۱۹] برای لحاظ کردن اثرات سطح تئوری جدیدی بر مبنای تئوری محیط پیوسته کلاسیک توسعه دادند. در مدل آنها سطح به عنوان یک غشای دو بعدی با ضخامت صفر و خواص متفاوت از ماده لایه‌های پایین تر در نظر گرفته می‌شود. انصاری و سهمانی [۲۰] اثر تنش‌های سطحی را بر پاسخ ارتعاشات آزاد نانو صفحات مطالعه کردند. وانگ و وانگ [۲۱] اثرات تنش‌های پسماند سطحی و الاستیسیته سطحی بر روی پاسخ ارتعاشات آزاد غیرخطی صفحه‌های کرشلف و میندلین را با استفاده از کرنش‌های ون کارمن مطالعه کردند. انصاری و همکاران [۲۲] اثر تنش‌های سطحی را بر روی پاسخ ارتعاش آزاد نانو صفحه‌های دایره‌ای با استفاده از الاستیسیته سطح گورتین مورداک و تئوری تغییر شکل‌های برشی مرتبه اول صفحات مطالعه کردند. وانگ و وانگ [۲۳] اثرات انرژی سطحی بر روی ناپایداری پولین یک نانو سوئیچ غیرخطی هندسی را بر مبنای تئوری تیر اویلر-برنولی مطالعه کردند. وانگ و همکاران [۲۴] اثر انرژی سطحی و تنش‌های حرارتی بر روی ناپایداری پولین یک صفحه دایره‌ای تحت تحریک الکترواستاتیک را با استفاده از تئوری الاستیسیته سطحی و تئوری تنش کوپل اصلاح شده مطالعه کردند. حمیدی و همکاران [۲۵] میرایی ترموالاستیک یک نانو تیر تشدید کننده را با استفاده از تئوری

همکاران [۳۳] اثرات تنش سطحی را بر روی رزونانس اصلی غیرخطی نانوپوسته های متخلخل مدرج تابعی تحت تحریک هارمونیک نرم خارجی با استفاده از تئوری الاستیسیته سطح گورتین-مورداک و تئوری کلاسیک پوسته ها مطالعه کردند. زی و همکاران [۳۴] تاثیر انرژی آزاد سطح را بر روی رزونانس ثانویه غیرخطی نانوتیرهای سیلیکونی متخلخل مدرج تابعی تحت تحریک سخت خارجی مطالعه کردند. آنها برای مدلسازی اثرات سطح بر روی رفتار دینامیکی نانوتیر اویلر برنولی از تئوری الاستیسیته ی سطح استفاده کردند و برای حل معادله از روش گلرکین و روش مقیاس های چند گانه استفاده کردند.

در این مقاله اثرات انرژی سطحی و اندازه بر روی رفتار رزونانس اصلی و ناپایداری پولین استاتیکی نانوصفحه دایره ای تحت تحریک غیرخطی الکترواستاتیکی بررسی شده است. معادلات حاکم با استفاده از روش همیلتون بدست آمد، سپس معادله استاتیکی با استفاده از روش خطی سازی گام به گام حل شده و در نهایت برای بدست آوردن پاسخ رزونانس اصلی نانوصفحه دایره ای معادله دینامیکی با استفاده از روش مقیاس های چندگانه حل شده است.

۲- استخراج معادله ارتعاشات عرضی نانوصفحه

یک سیستم نانو الکترومکانیکی شامل نانوصفحه دایره ای تحت تحریک الکترواستاتیک با شعاع R_0 و ضخامت h به همراه محورهای استوانه ای مناسب برای مدلسازی آن در شکل ۱ نشان داده شده است. صفحه بالایی به عنوان الکتروود تغییر شکل پذیر عمل می کند و صفحه پایینی یک الکتروود صلب است و فاصله اولیه بین دو الکتروود g_0 است. سطوح بالایی و پایینی نانوصفحه دایره ای تغییر شکل پذیر در $z = \pm h/2$ به ترتیب با S^+ و S^- نشان داده شده است.



شکل ۱- تصویر شماتیک نانوصفحه دایره ای تحت تحریک الکترواستاتیک.

های الاستیسیته سطحی، الاستیسیته ی غیر موضعی و ترموالاستیسیته گرین-نقدی بررسی کردند. حامد و همکاران [۲۶] اثر تنش پسماند سطحی را بر روی رفتار چند شاخگی نانولوله کربنی دو جداره حامل سیال تحریک پارامتریک بررسی کردند. عبدالرحمن و همکاران [۲۷] خمش استاتیکی نانوتیرهای پرفوره شده را با استفاده از تئوری الاستیسیته سطحی و تئوری تنش کوپل اصلاح شده مطالعه کردند.

میکرو و نانو صفحات با تحریک الکترواستاتیکی به صورت گسترده در ساختارهای میکرو و نانو الکترومکانیکی مانند سوئیچ ها و سنسورها مورد استفاده قرار می گیرند. در این ساختارها بین نیروی جاذبه الکترواستاتیکی و نیروی بازگرداننده مکانیکی (الاستیک) تعادل برقرار می شود، با افزایش ولتاژ DC هر دو نیروی الکترواستاتیک و بازگرداننده الاستیک افزایش می یابند. هنگامی که ولتاژ به مقدار بحرانی می رسد، نیروی الکترواستاتیک بر نیروی بازگرداننده الاستیک غالب می شود و باعث به هم چسبیدن الکتروودها و فروپاشی ساختار می شود. این نوع ناپایداری پولین نامیده می شود و ولتاژ متناظر آن ولتاژ پولین نامیده می شود. در طراحی نوسانگرها [۲۸] برای رسیدن به حرکات با ثبات از این ناپایداری ها جلوگیری می کنند، در حالی که در کاربردهای سوئیچینگ [۲۹] این اثر را برای بهینه سازی عملکرد دستگاه بکار می گیرند. برای واداشتن وسایل میکرو و نانو الکترومکانیکی به رزونانس، روش های مختلفی وجود دارد. متداول ترین روش، تحریک رزونانس اصلی است که در آن فرکانس تحریک نزدیک فرکانس طبیعی سازه است. مثال هایی از این نوع رزونانس در کاربردهای مختلفی مانند سنسورهای رزونانسی و فیلترهای رادیو فرکانسی مشاهده می شود. سرافراز و همکاران [۳۰] رزونانس زیر هارمونیک و فوق هارمونیک ارتعاشات غیرخطی نانوتیرها را با استفاده از تئوری تیر اویلر برنولی و الاستیسیته سطح مطالعه کردند. مامندی و میرزایی قلعه [۳۱] ارتعاشات غیرخطی وابسته به اندازه یک میکروتیر بر روی بستر وینکلر و بار فشاری در دو انتهای آن را با استفاده از تئوری تنش کوپل اصلاح شده مطالعه کردند. سرافراز و همکاران [۳۲] اثر انرژی سطحی را بر روی رزونانس اصلی غیرخطی نانوپوسته سیلیکونی تحت تحریک هارمونیک خارجی با استفاده از تئوری الاستیسیته سطح گورتین-مورداک و تئوری کلاسیک پوسته ها مطالعه کردند. سهمانی و

معادله ی بالا اندیس های α و β متناظر با مقادیر r و θ می باشند. با جایگذاری معادله ی (۲) در معادله ی (۶) و فرض این که مدول الاستیک سطحی و تنش کششی پسماند سطوح بالایی و پایینی با هم برابر باشند، تنش های سطحی به صورت زیر بدست می آیند:

$$\begin{aligned} \sigma_{rr}^{s\pm} &= \tau^s \mp \frac{E^s h}{2(1-\nu^2)} \left(\frac{\partial^2 w}{\partial r^2} + \frac{\nu}{r} \frac{\partial w}{\partial r} \right) \\ \sigma_{\theta\theta}^{s\pm} &= \tau^s \mp \frac{E^s h}{2(1-\nu^2)} \left(\nu \frac{\partial^2 w}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial w}{\partial r} \right) \\ \sigma_{rz}^{s\pm} &= \tau^s \frac{\partial w}{\partial r} \end{aligned} \quad (7)$$

گشتاورهای خمشی با استفاده ی هم زمان از معادلات (۳)، (۴)، (۵) و (۷) به ترتیب به شکل زیر بدست می آیند:

$$\begin{aligned} M_{rr} &= \int_{-h/2}^{h/2} \sigma_{rr} z dz + \frac{h}{2} (\sigma_{rr}^{s+} - \sigma_{rr}^{s-}) = \\ &= -(D + D^s) \left(\frac{\partial^2 w}{\partial r^2} + \frac{\nu}{r} \frac{\partial w}{\partial r} \right), \\ M_{\theta\theta} &= \int_{-h/2}^{h/2} \sigma_{\theta\theta} z dz + \frac{h}{2} (\sigma_{\theta\theta}^{s+} - \sigma_{\theta\theta}^{s-}) = \\ &= -(D + D^s) \left(\frac{1}{r} \frac{\partial w}{\partial r} + \nu \frac{\partial^2 w}{\partial r^2} \right), \\ M_{r\theta} &= \int_{-h/2}^{h/2} m_{r\theta} dz = -D^l \left(\frac{\partial^2 w}{\partial r^2} \right), \\ M_{\theta r} &= \int_{-h/2}^{h/2} m_{\theta r} dz = D^l \left(\frac{\partial^2 w}{\partial r^2} \right). \end{aligned} \quad (8)$$

که $D^l = 4Gl^2h$ ، $D = \frac{Eh^3}{12(1-\nu^2)}$ صلبیت خمشی، سهم گرادیان چرخش در صلبیت خمشی و $D^s = \frac{E^s h^2}{2(1-\nu^2)}$ سهم انرژی سطح در صلبیت خمشی است. نیروهای داخل صفحه‌ای به صورت زیر تعریف می شوند:

$$N_{rr} = \int_{-h/2}^{h/2} \sigma_{rr} dz + (\sigma_{rr}^{s+} + \sigma_{rr}^{s-}) = 2\tau^s. \quad (9)$$

تغییرات اول انرژی کرنشی کل صفحه دایره‌ای در بازه ی زمانی 0 تا T به صورت زیر است:

مولفه های جابه جایی برای نانوصفحه دایره‌ای کرشلف با تغییر شکل متقارن محوری به صورت زیر بیان می گردد:

$$\begin{aligned} u_r(r, \theta, z, t) &= -z \frac{\partial w(r, t)}{\partial r}, \\ u_\theta(r, \theta, z, t) &= 0, \quad u_z(r, \theta, z, t) = w(r, t). \end{aligned} \quad (1)$$

که u_r ، u_θ و u_z به ترتیب مولفه های جابه جایی در راستای شعاعی، محیطی و محوری در دستگاه مختصات استوانه‌ای هستند و w جابجایی نقطه‌ای بر روی سطح میانی صفحه است. با استفاده از معادله (۱) مولفه های غیر صفر تانسور کرنش به صورت زیر بدست می آیند:

$$\varepsilon_{rr} = -z \frac{\partial^2 w}{\partial r^2}, \quad \varepsilon_{\theta\theta} = -z \left(\frac{1}{r} \frac{\partial w}{\partial r} \right). \quad (2)$$

در حالت تنش صفحه‌ای، مولفه های تانسور تنش عبارتند از:

$$\begin{aligned} \sigma_{rr} &= \frac{E}{1-\nu^2} (\varepsilon_{rr} + \nu \varepsilon_{\theta\theta}) = -\frac{Ez}{1-\nu^2} \left(\frac{\partial^2 w}{\partial r^2} - \frac{\nu}{r} \frac{\partial w}{\partial r} \right), \\ \sigma_{\theta\theta} &= \frac{E}{1-\nu^2} (\varepsilon_{\theta\theta} + \nu \varepsilon_{rr}) = -\frac{Ez}{1-\nu^2} \left(\frac{1}{r} \frac{\partial w}{\partial r} + \nu \frac{\partial^2 w}{\partial r^2} \right). \end{aligned} \quad (3)$$

همچنین، مولفه های غیر صفر تانسور انحنای پادمتقارن عبارتند از [۸]:

$$\mu_{r\theta} = \frac{1}{2} \frac{\partial^2 w}{\partial r^2}, \quad \mu_{\theta r} = -\frac{1}{2} \frac{\partial^2 w}{\partial r^2}. \quad (4)$$

مولفه های غیر صفر تانسور تنش کوپل عبارتند از [۸]:

$$m_{r\theta} = -4Gl^2 \frac{\partial^2 w}{\partial r^2}, \quad m_{\theta r} = 4Gl^2 \frac{\partial^2 w}{\partial r^2}. \quad (5)$$

که در آن G مدول برشی ماده و l پارامتر مقیاس طول است که اثرات تنش کوپل را اندازه گیری می کند. با استفاده از تئوری سطح گورتین-مورداک [۱۸، ۱۹] معادلات مشخصه لایه های سطحی را می توان به صورت زیر نوشت:

$$\begin{aligned} \sigma_{\alpha\beta}^{s\pm} &= \tau^{s\pm} \delta_{\alpha\beta} + \lambda^{s\pm} \varepsilon_{\gamma\gamma}^{s\pm} \delta_{\alpha\beta} + 2\mu^{s\pm} \varepsilon_{\alpha\beta}^{s\pm} \\ \sigma_{\gamma z}^{s\pm} &= \tau^{s\pm} \frac{\partial w}{\partial \gamma} \end{aligned} \quad (6)$$

که در آن $\sigma_{\alpha\beta}^{s\pm}$ و $\varepsilon_{\alpha\beta}^{s\pm}$ به ترتیب نشان دهنده ی کرنش و تنش در لایه های سطحی هستند. $\lambda^{s\pm}$ و $\mu^{s\pm}$ ضرایب لامه و تابع دلتای کرانکر هستند. $E^{s\pm}$ و $\tau^{s\pm}$ به ترتیب مدول الاستیک سطحی و تنش کششی پسماند سطحی هستند. در

$$\frac{\partial^2 M_{rr}}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial M_{rr}}{\partial r} - \frac{1}{r} \frac{\partial M_{\theta\theta}}{\partial r} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 M_{r\theta}}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial M_{r\theta}}{\partial r} - \frac{1}{2} \frac{\partial^2 M_{\theta r}}{\partial r^2} - \frac{1}{r} \frac{\partial M_{\theta r}}{\partial r} \quad (14)$$

$$+ \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r N_{rr} \frac{\partial w}{\partial r} \right) + q(r) = (\rho h + 2\rho^s) \frac{\partial^2 w}{\partial t^2} + \left(\frac{\partial}{\partial r} (r M_{rr}) - M_{\theta\theta} - r N_{rr} \frac{\partial w}{\partial r} + \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial r} (r M_{r\theta}) - \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial r} (r M_{\theta r}) \right) \delta w |_{r=0, R_0} \quad (15)$$

$$\left(M_{rr} + \frac{M_{r\theta}}{2} - \frac{M_{\theta r}}{2} \right) \delta \left(\frac{\partial w}{\partial r} \right) |_{r=0, R_0} = 0$$

با جایگذاری معادلات (۸) و (۹) در معادله (۸)، معادله ارتعاشات صفحه به صورت زیر بدست می‌آید:

$$(D + D^s) \nabla^4 w + D^l \left(\frac{\partial^4 w}{\partial r^4} + \frac{2}{r} \frac{\partial^3 w}{\partial r^3} - 2\tau^s \nabla^2 w \right) + (\rho h + 2\rho^s) \frac{\partial^2 w}{\partial t^2} = q \quad (16)$$

که در آن $\nabla^2 = \left(\frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \right)$ عملگر لاپلاس و $\nabla^4 = \left(\frac{\partial^4}{\partial r^4} + \frac{2}{r} \frac{\partial^3}{\partial r^3} - \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{1}{r^3} \frac{\partial}{\partial r} \right)$ عملگر بای هارمونیک در دستگاه مختصات قطبی هستند. نیروی خارجی اعمال شده بر صفحه را می‌توان به صورت زیر نوشت:

$$q = F_e + F_c - F_v \quad (17)$$

که در آن F_e, F_v, F_c به ترتیب نیروی کزمیر ناشی از برهم کنش مولکولی بین دو صفحه، نیروی میرایی ایجاد شده توسط سیال و نیروی الکترواستاتیکی هستند. وقتی که اختلاف پتانسیل الکتریکی V بین دو صفحه ی دایره ای موازی اعمال بشود، مقدار نیروی الکترواستاتیک ایجاد شده بین دو صفحه را می‌توان به صورت زیر بیان کرد [۳۵]:

$$F_e = \frac{\epsilon_0 V^2}{2(g_0 - w)^2} \quad (18)$$

که در آن ϵ_0 ضریب دی الکتریک خلاء هست. نیروی کزمیر ناشی از اندرکنش مولکولی بین دو صفحه به صورت معادله ی زیر بیان می‌شود [۳۶]:

$$F_c = \frac{\bar{h}c\pi^2}{240(g_0 - w)^4} \quad (19)$$

$$\delta \int_0^T U dt = \int_0^T \int_{\Omega} \left(\sigma_{rr} \delta \epsilon_{rr} + \sigma_{\theta\theta} \delta \epsilon_{\theta\theta} + m_{r\theta} \delta \mu_{r\theta} + m_{\theta r} \delta \mu_{\theta r} \right) d\Omega dt + \int_0^T \int_{S^+} (\sigma_{rr}^{s+} \delta \epsilon_{rr}^{s+} + \sigma_{\theta\theta}^{s+} \delta \epsilon_{\theta\theta}^{s+}) dAdt + \int_0^T \int_{S^-} (\sigma_{rr}^{s-} \delta \epsilon_{rr}^{s-} + \sigma_{\theta\theta}^{s-} \delta \epsilon_{\theta\theta}^{s-}) dAdt \quad (10)$$

با جایگذاری معادلات (۲) - (۷) در معادله (۱۰) تغییرات انرژی کرنشی صفحه به صورت زیر بدست می‌آید:

$$\delta \int_0^T U dt = \int_0^T \int_{\Omega} N_{rr} \delta \left(\frac{1}{2} \frac{\partial w}{\partial r} \right)^2 dAdt - \int_0^T \int_{\Omega} M_{rr} \delta \left(\frac{\partial^2 w}{\partial r^2} \right) dAdt - \int_0^T \int_{\Omega} M_{\theta\theta} \delta \left(\frac{1}{r} \frac{\partial w}{\partial r} \right) dAdt - \int_0^T \int_{\Omega} M_{r\theta} \delta \left(\frac{1}{2} \frac{\partial^2 w}{\partial r^2} \right) dAdt - \int_0^T \int_{\Omega} M_{\theta r} \delta \left(-\frac{1}{2} \frac{\partial^2 w}{\partial r^2} \right) dAdt \quad (11)$$

با صرفنظر کردن از اثر اینرسی دورانی و چگالی سطح، تغییرات اول انرژی جنبشی به صورت زیر بدست می‌آید:

$$\delta \int_0^T K dt = - \int_0^T \int_{\Omega} (\rho h + 2\rho^s) \frac{\partial^2 w}{\partial t^2} \delta w d\Omega dt \quad (12)$$

که در آن ρ و ρ^s به ترتیب چگالی نانوصفحه و چگالی سطح می‌باشند. تغییرات اول کار که به وسیله ی بار گسترده ی $q(r)$ در بازه ی زمانی 0 تا T اعمال می‌گردد برابر است با:

$$\delta \int_0^T W dt = \int_0^T \int_{\Omega} q \delta w d\Omega dt. \quad (13)$$

با جایگذاری روابط (۱۱) - (۱۳) در معادله همیلتون $\left(\delta \int_0^T (K - U + W) dt = 0 \right)$ و استفاده از معادلات (۸) و (۹) معادله ی دیفرانسیلی حاکم بر حرکت عرضی صفحه دایره‌ای و شرایط مرزی آن به صورت زیر بدست می‌آیند:

۳- حل معادلات

نانوصفحه دایره‌ای توسط ولتاژ $V = V_{dc} + V_{ac} \cos(\Omega t)$ تحریک می‌شود. بدین ترتیب که ابتدا نانو صفحه توسط ولتاژ پایه خم می‌شود، سپس توسط ولتاژ هارمونیک V_{ac} برانگیخته می‌شود تا حول حالت تعادل استاتیکی ارتعاش کند؛ بنابراین خمیدگی کل می‌تواند به صورت زیر نوشته شود:

$$\widehat{w}(\widehat{r}, \widehat{t}) = \widehat{w}_s(\widehat{r}) + \widehat{w}_d(\widehat{r}, \widehat{t}) \quad (25)$$

که $\widehat{w}_s(\widehat{r})$ نشان دهنده خیز استاتیکی ایجاد شده در اثر ولتاژ پایه و $\widehat{w}_d(\widehat{r}, \widehat{t})$ خیز دینامیکی یا ارتعاش نانو صفحه حول $\widehat{w}_s(\widehat{r})$ است. با جایگذاری معادله (25) در معادله (23) و بسط دادن نیروی الکترواستاتیکی حول حالت تعادل استاتیکی آن، معادله غیرخطی خیز استاتیکی و دینامیکی نانوصفحه دایره‌ای به صورت زیر بدست می‌آیند:

$$D^* \widehat{\nabla}^4 \widehat{w}_s + D^c \left(\frac{\partial^4 \widehat{w}_s}{\partial \widehat{r}^4} + \frac{2}{\widehat{r}} \frac{\partial^3 \widehat{w}_s}{\partial \widehat{r}^3} \right) - \alpha_s \widehat{\nabla}^2 \widehat{w}_s = \frac{\alpha_e V_{dc}^2}{(1 - \widehat{w}_s)^2} + \frac{\alpha_e}{(1 - \widehat{w}_s)^4} \quad (26)$$

$$D^* \widehat{\nabla}^4 \widehat{w}_d + D^c \left(\frac{\partial^4 \widehat{w}_d}{\partial \widehat{r}^4} + \frac{2}{\widehat{r}} \frac{\partial^3 \widehat{w}_d}{\partial \widehat{r}^3} \right) - \alpha_s \widehat{\nabla}^2 \widehat{w}_d + \frac{\partial^2 \widehat{w}_d}{\partial \widehat{t}^2} + \widehat{c} \frac{\partial \widehat{w}_d}{\partial \widehat{t}} - \left(\frac{2\alpha_e V_{dc}^2}{(1 - \widehat{w}_s)^3} + \frac{4\alpha_e}{(1 - \widehat{w}_s)^5} + \frac{4\alpha_e V_{dc} V_{ac} \cos(\widehat{\Omega} \widehat{t})}{(1 - \widehat{w}_s)^3} \right) \widehat{w}_d - \left(\frac{3\alpha_e V_{dc}^2}{(1 - \widehat{w}_s)^4} + \frac{10\alpha_e}{(1 - \widehat{w}_s)^6} \right) \widehat{w}_d^2 - \left(\frac{4\alpha_e V_{dc}^2}{(1 - \widehat{w}_s)^5} + \frac{20\alpha_e}{(1 - \widehat{w}_s)^7} \right) \widehat{w}_d^3 = \left(\frac{2\alpha_e V_{dc} V_{ac} \cos(\widehat{\Omega} \widehat{t})}{(1 - \widehat{w}_s)^2} \right) \widehat{w}_d^3$$

۳-۱- حل استاتیکی

در این بخش برای حل معادله استاتیکی از روش خطی سازی گام به گام استفاده شده است [38]. بر این اساس، تغییر شکل بی‌بعد نانوصفحه، تحت تاثیر ولتاژ DC اعمالی V^k تعریف می‌گردد. با افزایش ولتاژ اعمالی $(V^{k+1} = V^k + \delta V)$ ، خیز استاتیکی بی‌بعد به صورت زیر در نظر گرفته می‌شود:

$$\widehat{w}^{k+1} \rightarrow \widehat{w}^k + \delta w = \widehat{w}^k + \chi. \quad (27)$$

با در نظر گرفتن مقادیر کوچک برای δV انتظار می‌رود که χ به اندازه‌ی کافی کوچک باشد؛ بنابراین برای مقدار مناسب δV می‌توان با استفاده از بسط سری تیلور مرتبه‌ی اول به دقت

که در آن c سرعت نور در خلاء و \bar{h} ثابت پلانک هست. نیروی میرایی معادل به صورت تقریبی با استفاده از معادله رینولدز به صورت زیر نوشته می‌شود [37]:

$$F_v = \frac{3\mu A^2}{2\pi g_0^3} \frac{\partial w}{\partial t} \quad (20)$$

که در آن μ ویسکوزیته سیال و A مساحت صفحه است. با جایگذاری معادلات (18) - (20) در معادله (17) و سپس جایگذاری معادله حاصل در معادله (16)، معادله غیرخطی حاکم بر ارتعاشات عرضی نانو صفحه دایره‌ای به صورت زیر بدست می‌آید:

$$(D + D^s) \nabla^4 w + D^l \left(\frac{\partial^4 w}{\partial r^4} + \frac{2}{r} \frac{\partial^3 w}{\partial r^3} \right) - 2\tau^s \nabla^2 w + (\rho h + 2\rho^s) \frac{\partial^2 w}{\partial t^2} = \frac{\varepsilon_0 V^2}{2(g_0 - w)^2} + \frac{\bar{h} c \pi^2}{240(g_0 - w)^4} - \frac{3\mu A^2}{2\pi g_0^3} \frac{\partial w}{\partial t} \quad (21)$$

برای راحتی تحلیل داده‌ها متغیرهای بدون بعد به صورت زیر معرفی می‌شوند:

$$\widehat{w} = \frac{w}{g_0}, \widehat{r} = \frac{r}{R_0}, \widehat{z} = \frac{z}{g_0}, \widehat{t} = \frac{t}{t^*}, \widehat{\Omega} = \Omega t^* \quad (22)$$

با استفاده از متغیرهای بالا معادله (21) به صورت معادله بی بعد زیر بازنویسی می‌شود:

$$D^* \widehat{\nabla}^4 \widehat{w} + D^c \left(\frac{\partial^4 \widehat{w}}{\partial \widehat{r}^4} + \frac{2}{\widehat{r}} \frac{\partial^3 \widehat{w}}{\partial \widehat{r}^3} \right) - \alpha_s \widehat{\nabla}^2 \widehat{w} + \frac{\partial^2 \widehat{w}}{\partial \widehat{t}^2} + \widehat{c} \frac{\partial \widehat{w}}{\partial \widehat{t}} = \frac{\alpha_e V^2}{(1 - \widehat{w})^2} + \frac{\alpha_c}{(1 - \widehat{w})^4} \quad (23)$$

که در آن

$$D^* = \frac{D + D^s}{D}, D^c = \frac{D^l}{D}, \alpha_s = \frac{2\tau^s R_0^2}{D}, \alpha_e = \frac{\varepsilon_0 R_0^4}{2g_0^3 D}, \alpha_c = \frac{\bar{h} c \pi^2 R_0^4}{240 g_0^3 D}, \widehat{\nabla}^4 = \left(\frac{\partial^4}{\partial \widehat{r}^4} + \frac{2}{\widehat{r}} \frac{\partial^3}{\partial \widehat{r}^3} - \frac{1}{\widehat{r}^2} \frac{\partial^2}{\partial \widehat{r}^2} + \frac{1}{\widehat{r}^3} \frac{\partial}{\partial \widehat{r}} \right), \widehat{\nabla}^2 = \left(\frac{\partial^2}{\partial \widehat{r}^2} + \frac{1}{\widehat{r}} \frac{\partial}{\partial \widehat{r}} \right), t^* = R_0^2 \sqrt{\frac{12(\rho h + 2\rho^s)(1 - \nu^2)}{Eh^3}}, \widehat{c} = \frac{3\mu A^2 R_0^4}{2\pi g_0^3 t^* D} \quad (24)$$

گانه [۳۹] استخراج شده است. خیز دینامیکی نانو صفحه می تواند به صورت مجموع تعداد محدودی از تابع شکل های مناسب با ضرایب وابسته به زمان نوشته شود:

$$\hat{w}_d(\hat{r}, \hat{t}) = \sum_{n=1}^N u_n(\hat{t}) \psi_n(\hat{r}), \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (32)$$

که u_n مختصات تعمیم یافته نانوصفحه و $\psi_n(\hat{r})$ شکل مدهای طبیعی نانوصفحه است. با جایگذاری کردن معادله (۳۲) در معادله (۲۶)، سپس ضرب کردن معادله حاصل در $\psi_k(\hat{r})$ و انتگرالگیری بر روی دامنه و قراردادن $N, N = 1$ در $\psi_k(\hat{r}) = \psi(\hat{r})$ و $u_1(\hat{t}) = u(\hat{t})$ در معادله حاصل تقریب تک مد منجر به معادله غیرخطی زیر می شود:

$$I_0 \ddot{u} + I_1 \dot{u} + (I_2 - I_3 \cos(\hat{\Omega} \hat{t})) u - I_4 u^2 - I_5 u^3 = I_6 \cos(\hat{\Omega} \hat{t}) \quad (33)$$

که در آن

$$I_0 = \int_0^1 \psi^2 d\hat{r}, \quad I_1 = \hat{c} \int_0^1 \psi^2 d\hat{r}, \quad I_3 = \int_0^1 \frac{4\alpha_e V_{dc} V_{ac} \psi^2}{(1-\hat{w}_s)^3} d\hat{r},$$

$$I_2 = D^* \int_0^1 \psi \hat{\nabla}^4 \psi d\hat{r} + D^c \int_0^1 \psi \left(\frac{d^4 \psi}{d\hat{r}^4} + \frac{2}{\hat{r}} \frac{d^3 \psi}{d\hat{r}^3} \right) d\hat{r}$$

$$- \alpha_s \int_0^1 \psi \hat{\nabla}^2 \psi d\hat{r} - \int_0^1 \left(\frac{2\alpha_e V_{dc}^2 \psi^2}{(1-\hat{w}_s)^3} + \frac{4\alpha_c \psi^2}{(1-\hat{w}_s)^5} \right) d\hat{r},$$

$$I_4 = \int_0^1 \left(\frac{3\alpha_e V_{dc}^2 \psi^3}{(1-\hat{w}_s)^4} + \frac{10\alpha_c \psi^3}{(1-\hat{w}_s)^6} \right) d\hat{r}, \quad (34)$$

$$I_5 = \int_0^1 \left(\frac{4\alpha_e V_{dc}^2 \psi^4}{(1-\hat{w}_s)^5} + \frac{20\alpha_c \psi^4}{(1-\hat{w}_s)^7} \right) d\hat{r}, \quad I_6 = \int_0^1 \frac{2\alpha_e V_{dc} V_{ac} \psi}{(1-\hat{w}_s)^2} d\hat{r},$$

معادله (۳۳) را می توان به صورت زیر بازنویسی کرد:

$$\ddot{u} + \xi \dot{u} + (\omega^2 - \kappa_1 \cos(\hat{\Omega} \hat{t})) u - \kappa_2 u^2 - \kappa_3 u^3 = \eta \cos(\hat{\Omega} \hat{t}), \quad (35)$$

$$\xi = \frac{I_1}{I_0}, \quad \omega^2 = \frac{I_2}{I_0}, \quad \kappa_1 = \frac{I_3}{I_0}, \quad \kappa_2 = \frac{I_4}{I_0}, \quad \kappa_3 = \frac{I_5}{I_0}, \quad \eta = \frac{I_6}{I_0}.$$

برای حل نیمه تحلیلی معادله بالا با استفاده از روش مقیاس های چندگانه، متغیرهای مقیاس بندی شده به صورت زیر معرفی می شوند:

کافی دست یافت. می توان χ را با سری متناهی از توابع پایه $\varphi_i(\hat{r})$ به صورت زیر بسط داد:

$$\chi(\hat{r}) = \sum_{i=1}^N a_i \varphi_i(\hat{r}). \quad (28)$$

به طوری که a_i ضرایب مجهول هستند که باید محاسبه شوند. اگر توابع پایه شرایط مرزی هندسی مسئله را ارضا کنند χ نیز شرایط مرزی را ارضا می کند؛ بنابراین با تفریق کردن معادله گام k از گام $k+1$ و استفاده از بسط سری تیلور، شکل خطی سازی شده معادله استاتیکی به صورت زیر بازنویسی می شود:

$$D^* \hat{\nabla}^4 \chi + D^c \left(\frac{d^4 \chi}{d\hat{r}^4} + \frac{2}{\hat{r}} \frac{d^3 \chi}{d\hat{r}^3} \right) - \alpha_s \hat{\nabla}^2 \chi - \frac{2\alpha_e (V^i)^2}{(1-\hat{w}^i)^3} \chi - \frac{4\alpha_c}{(1-\hat{w}^i)^5} \chi = \frac{2\alpha_e V^i \delta V}{(1-\hat{w}^i)^2}. \quad (29)$$

با جایگذاری معادله (۲۸) در معادله بالا و ضرب کردن مانده آن در توابع وزن و انتگرال گیری در دامنه نانوصفحه، مجموعه ای از معادلات جبری به صورت زیر بدست می آید:

$$\sum_{i=1}^N (K_{ji} - K'_{ji} - K''_{ji}) a_i = F_j^e, \quad j = 1, 2, \dots, N \quad (30)$$

که در آن داریم

$$K_{ji} = (D^* + D^c) \left(\int_0^1 \varphi_j \frac{d^4 \varphi_i}{d\hat{r}^4} d\hat{r} + 2 \int_0^1 \frac{\varphi_j}{\hat{r}} \frac{d^3 \varphi_i}{d\hat{r}^3} d\hat{r} \right) + D^* \left(- \int_0^1 \frac{\varphi_j}{\hat{r}^2} \frac{d^2 \varphi_i}{d\hat{r}^2} d\hat{r} + \int_0^1 \frac{\varphi_j}{\hat{r}^3} \frac{d\varphi_i}{d\hat{r}} d\hat{r} \right), \quad (31)$$

$$K'_{ji} = \alpha_s \left(\int_0^1 \varphi_j \frac{d^2 \varphi_i}{d\hat{r}^2} d\hat{r} + \int_0^1 \frac{\varphi_j}{\hat{r}} \frac{d\varphi_i}{d\hat{r}} d\hat{r} \right) + 4\alpha_c \int_0^1 \frac{\varphi_j \varphi_i}{(1-\hat{w}^i)^5} d\hat{r},$$

$$K''_{ji} = 2\alpha_e V^{i2} \int_0^1 \frac{\varphi_j \varphi_i}{(1-\hat{w}^i)^3} d\hat{r}, \quad F_j^e = 2\alpha_e V^i \delta V \int_0^1 \frac{\varphi_j}{(1-\hat{w}^i)^2} d\hat{r}.$$

با حل N معادله جبری، ضرایب مجهول a_i و تغییر شکل نانوصفحه در هر گام تعیین می شود.

۳-۲- حل معادله دینامیکی

در این بخش با استفاده از روش مانده های وزنی گلرکین معادله دیفرانسیل حاکم به یک معادله کاهش مرتبه یافته تبدیل شده است و نمودارهای پاسخ فرکانسی رزونانس غیرخطی نانوصفحه دایره ای با استفاده از روش مقیاس ها چند

$$D_1 A = 0 \quad (۴۷)$$

حل خصوصی معادله (۴۶) بصورت زیر بدست می‌آید:

$$u_1 = -\frac{\kappa_2 A^2}{3\omega^2} e^{2i\omega T_0} + \frac{\kappa_2}{\omega^2} A \bar{A} + cc. \quad (۴۸)$$

رزونانس اصلی وقتی اتفاق می‌افتد که فرکانس تحریک Ω نزدیک فرکانس خطی سیستم ω باشد. با معرفی کردن یک پارامتر تنظیم کننده σ به همراه پارامتر کوچک ε ، Ω را می‌توان به صورت زیر نوشت:

$$\Omega = \omega + \varepsilon^2 \sigma. \quad (۴۹)$$

با جایگذاری معادلات (۴۵)، (۴۸) و (۴۹) در معادله (۴۴) داریم:

$$D_0^2 u_2 + \omega^2 u_2 = \left(\kappa_3 A^3 - \frac{2\kappa_2^2 A^3}{3\omega^2} \right) e^{3i\omega T_0} + \left(3\kappa_3 A^2 \bar{A} - i\omega \xi A - 2i\omega D_2 A + \frac{10\kappa_2^2 A^2 \bar{A}}{3\omega^2} + \frac{1}{2} \eta e^{i\sigma T_2} \right) e^{i\omega T_0} + \frac{\kappa_1 A}{2} e^{i(\Omega+\omega)T_0} + \frac{\kappa_1 \bar{A}}{2} e^{i(\Omega-\omega)T_0} + cc. \quad (۵۰)$$

ترم‌های تکین از مقایسه ترم‌های همگن با ناهمگن شناسایی می‌شود؛ بنابراین با حذف ترم‌های تکین در معادله بالا داریم:

$$-2i\omega D_2 A - i\omega \xi A + 3\kappa_3 A^2 \bar{A} + \frac{10\kappa_2^2 A^2 \bar{A}}{3\omega^2} + \frac{1}{2} \eta e^{i\sigma T_2} = 0 \quad (۵۱)$$

برای پیدا کردن پاسخ حالت ماندگار ارتعاشات نانوصفحه تابع مختلط A به صورت قطبی $A = \frac{1}{2} \bar{a} e^{i\beta}$ نوشته می‌شود که \bar{a} دامنه ارتعاش عرضی و β زاویه فاز آن است. با جایگذاری A در معادله (۵۱) و جدا کردن قسمت حقیقی و موهومی معادله حاصل داریم:

$$\frac{d\bar{a}}{dT_2} = -\frac{\xi \bar{a}}{2} + \frac{\eta}{2\omega} \sin(\gamma) \quad (۵۲)$$

$$\frac{d\gamma}{dT_2} = \sigma + \left(\frac{5\kappa_2^2}{12\omega^3} + \frac{3\kappa_3}{8\omega} \right) \bar{a}^2 + \frac{\eta}{2\omega \bar{a}} \cos(\gamma)$$

که در آن زاویه فاز با $\gamma = \sigma T_2 - \beta$ جایگزین شده است. با فرض شرایط پایا ($d\bar{a}/dT_1 = d\gamma/dT_1 = 0$) و حذف γ در معادله (۵۲)، معادله پاسخ فرکانسی زیر بدست می‌آید:

$$\xi = \varepsilon^2 \xi, \kappa_1 = \kappa_1 \varepsilon^2, \kappa_2 = \kappa_2 \varepsilon, \kappa_3 = \kappa_3 \varepsilon^2, \eta = \eta \varepsilon^2 \quad (۳۶)$$

معادله (۳۵) را می‌توان به شکل زیر بازنویسی کرد:

$$\ddot{u} + \varepsilon^2 \xi \dot{u} + (\omega^2 - \kappa_1 \varepsilon^2 \cos(\Omega t)) u - \kappa_2 \varepsilon u^2 - \kappa_3 \varepsilon^2 u^3 = \eta \varepsilon^2 \cos(\Omega t) \quad (۳۷)$$

مطابق روش مقیاس‌های چندگانه زمان‌های مقیاس بندی T_n مشتقات زمانی به شکل زیر تعریف می‌شوند:

$$T_n = \varepsilon^n t \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (۳۸)$$

$$\frac{d}{dt} = \frac{dT_0}{dt} \frac{\partial}{\partial T_0} + \frac{dT_1}{dt} \frac{\partial}{\partial T_1} + \dots = D_0 + \varepsilon D_1 + \varepsilon^2 D_2 + \dots \quad (۳۹)$$

$$\frac{d^2}{dt^2} = D_0^2 + 2\varepsilon D_0 D_1 + \varepsilon^2 (D_1^2 + 2D_0 D_2) + \dots \quad (۴۰)$$

می‌توان حل معادله (۳۵) را بر حسب ε بسط داد:

$$u(t) = u_0(T_0, T_1, T_2, \dots) + \varepsilon u_1(T_0, T_1, T_2, \dots) + \dots \quad (۴۱)$$

با جایگذاری معادلات (۳۸) - (۴۱) در معادله (۳۷) معادلات زیر حاصل می‌شوند:

$$D_0^2 u_0 + \omega^2 u_0 = 0 \quad (۴۲)$$

$$D_0^2 u_1 + \omega^2 u_1 = \kappa_2 u_0^2 - 2D_0 D_1 u_0 \quad (۴۳)$$

$$D_0^2 u_2 + \omega^2 u_2 = 2\kappa_2 u_0 u_1 - \xi D_0 u_0 + \kappa_3 u_0^3 - 2D_0 D_2 u_0 - D_1^2 u_0 - 2D_0 D_1 u_1 + \kappa_1 u_0 \cos(\Omega T_0) + \eta \cos(\Omega T_0) \quad (۴۴)$$

حل کلی معادله (۴۲) را می‌توان به صورت زیر نوشت:

$$u_0(T_0, T_1, T_2) = A(T_1, T_2) e^{i\omega T_0} + \bar{A}(T_1, T_2) e^{-i\omega T_0} \quad (۴۵)$$

که در آن $i^2 = -1$ یک تابع مختلط است که دامنه پاسخ آهسته را نشان می‌دهد و علامت بار نشان دهنده مزدوج مختلط کمیت است. جایگذاری u_0 در معادله (۴۳) نتیجه می‌دهد:

$$D_0^2 u_1 + \omega^2 u_1 = -2i\omega D_1 A e^{i\omega T_0} + \kappa_2 A^2 e^{2i\omega T_0} + \kappa_2 A \bar{A} + cc. \quad (۴۶)$$

که cc مزدوج مختلط ترم‌های قبلی را نشان می‌دهد. شرایط حذف ترم‌های تکین در معادله (۴۶) منجر به معادله زیر می‌شود:

خطی معادل سیستم هم تغییر می کند، ولی بسته به مقادیر E^s و τ^s ممکن هست، مقدار آن افزایش یا کاهش یابد. با استفاده از روابط (۳۳) و (۳۴) می توان تغییرات ضریب سفتی خطی در اثر لحاظ کردن اثرات سطح را به صورت رابطه زیر بدست آورد:

$$\Delta I_2 = \frac{E^s h^2}{2D(1-\nu^2)} \int_0^1 \psi \hat{\nabla}^4 \psi d\hat{r} - \frac{2\tau^s R_0^2}{D} \int_0^1 \psi \hat{\nabla}^2 \psi d\hat{r} \quad (57)$$

برای خواص مکانیکی، شرایط مرزی و ابعاد مساله مورد مطالعه اگر علامت ΔI_2 مثبت باشد، می توان نتیجه گرفت که لحاظ کردن اثرات سطح باعث سفت تر شدن سیستم شده است و اگر علامت ΔI_2 منفی باشد، می توان گفت که اثرات سطح باعث نرم تر شدن آن شده است.

۵- نتایج عددی:

برای نمونه محاسبات عددی برای یک نانوصفحه دایره ای از جنس آلومینیوم و هوا به عنوان سیال انجام شده است، مشخصات هندسی و خواص [۴۰, ۴۱] در جدول ۱ لیست شده اند. برای همه نمودارها دامنه ارتعاش نقطه مرکزی نانو صفحه محاسبه شده است و علامت بالای متغیرهای بی بعد در شکلها نشان داده نشده است. در این مقاله برای استخراج معادله حرکت نانو صفحه دایره ای از فرضیات تئوری صفحات نازک کرشلف و رابطه خطی بین کرنش و تغییر مکان استفاده شد. باید توجه کنیم که در صورت کوچک بودن دامنه ارتعاشات، نتایج بدست آمده از حل این معادله می تواند درست باشد. اگر دامنه ارتعاشات بزرگ باشد، اثرات غیرخطی هندسی اهمیت پیدا می کنند و نتایج حل این معادله معتبر نخواهد بود. اثرات غیرخطی هندسی ممکن است از کشیدگی و یا انحنای بزرگ ناشی شود. کشیدگی صفحه میانی نانوصفحه منجر به ارتباطی غیرخطی بین کرنش و تغییر مکان می شود.

۵-۱- پاسخ حل استاتیکی:

برای پیدا کردن بهترین اندازه ی گام در روش خطی سازی گام به گام و نشان دادن همگرایی در تعداد مودها (N)، در جدول ۲ ولتاژ پولین استاتیکی صفحه برای $R_0 = 250 \mu\text{m}$ ، $h = 20 \mu\text{m}$ و $g_0 = 1 \mu\text{m}$ ، $\nu = 0.3$ ، $E = 169 \text{ GPa}$

$$\left[(9\kappa_3 \omega^2 \bar{a}^2 + 10\kappa_2 \bar{a}^2 + 24\omega^3 \sigma) + 144\xi^2 \omega^6 \right] \bar{a}^2 = 144\eta^2 \omega^4 \quad (53)$$

برای مطالعه پایداری پاسخ ماندگار سیستم رفتار آن در همسایگی نقطه تکین (\bar{a}_0, γ_0) بررسی شده است. با جایگذاری تغییرات جزئی $\bar{a} = \bar{a}_0 + \delta \bar{a}$ و $\gamma = \gamma_0 + \delta \gamma$ در معادله (۵۲) و حذف ترم های غیرخطی از $\delta \bar{a}$ و $\delta \gamma$ داریم:

$$\frac{d\delta \bar{a}}{dT_1} = -\frac{\xi}{2} \delta \bar{a} + \frac{\eta}{2\omega} \cos(\gamma_0) \delta \gamma \quad (54)$$

$$\frac{d\delta \gamma}{dT_1} = \left(2\bar{a}_0 \left(\frac{5\kappa_2^2}{12\omega^3} + \frac{3\kappa_3}{8\omega} \right) - \frac{\eta}{2\omega \bar{a}_0^2} \cos(\gamma_0) \right) \delta \bar{a} - \frac{\eta}{2\omega \bar{a}_0} \sin(\gamma_0) \delta \gamma$$

که پایداری معادله حالت (۵۴) به مقادیر ویژه ماتریس ژاکوبین بستگی دارد. ماتریس ژاکوبین را می توان با حذف γ_0 در معادله (۵۴) بدست می آید.

$$J = \begin{bmatrix} -\frac{\xi}{2} & -\sigma \bar{a}_0 - \left(\frac{5\kappa_2^2}{12\omega^3} + \frac{3\kappa_3}{8\omega} \right) \bar{a}_0^3 \\ \frac{\sigma}{\bar{a}_0} + 3 \left(\frac{5\kappa_2^2}{12\omega^3} + \frac{3\kappa_3}{8\omega} \right) \bar{a}_0 & -\frac{\xi}{2} \end{bmatrix} \quad (55)$$

که معادله مشخصه آن به صورت زیر بدست می آید:

$$\lambda^2 + \xi \lambda + \left(\frac{\xi^2}{4} + \sigma^2 + 4\sigma \left(\frac{5\kappa_2^2}{12\omega^3} + \frac{3\kappa_3}{8\omega} \right) \bar{a}_0^2 \right) = 0 \quad (56)$$

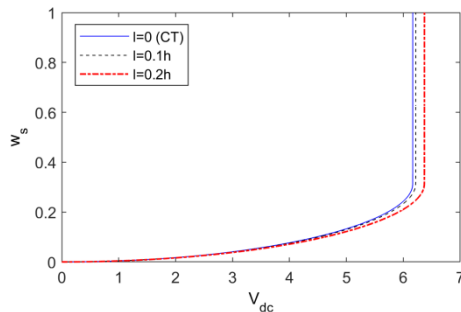
که برای $\text{Re}(\lambda) < 0$ حل پایدار خواهد بود.

۴- تاثیر لحاظ کردن اثرات سطح بر روی پارامتر

های ارتعاشی نانوصفحه دایره ای :

برای بررسی بهتر تاثیر لحاظ کردن اثرات سطح بر روی رفتار نانو صفحه دایره ای باید تاثیر لحاظ کردن اثرات سطح بر روی پارامترهای ارتعاشی آن بررسی شود. با توجه به معادلات بدست آمده در بخش های قبلی می توان نتیجه گرفت که لحاظ کردن اثرات سطح بر روی دو پارامتر جرم و ضریب سفتی خطی معادل سیستم تاثیرگذار است. با توجه به معادلات می توان متوجه شد که لحاظ کردن اثرات سطح باعث افزایش جرم معادل سیستم می شود؛ ضریب سفتی

برای مقایسه‌ی نتایج بدست آمده برای ولتاژ پولین استاتیکی نانوصفحه با استفاده از تئوری تنش کوپل سازگار (CCST) و تئوری کلاسیک (CT)، تغییر شکل استاتیکی مرکز صفحه بر حسب ولتاژ در شکل ۲ رسم شده است. شکل ۲ نشان می‌دهد، که استفاده از تئوری تنش کوپل سازگار منجر به مدل سفت تری از نانو صفحه می‌شود و بنابراین مقدار ولتاژ پولین استاتیکی محاسبه شده را به مقدار بزرگتر انتقال می‌دهد و با افزایش مقدار پارامتر مقیاس طول اختلاف نتایج دو تئوری بیشتر می‌شود.



شکل ۲- اثر پارامتر مقیاس طول روی مقدار ولتاژ پولین استاتیکی نانوصفحه دایره‌ای.

شکل ۳ تاثیر لحاظ کردن اثرات سطح بر ولتاژ ناپایداری استاتیکی را نشان می‌دهد. با توجه به شکل می‌توان متوجه شد که لحاظ کردن اثرات سطح باعث افزایش مقدار ولتاژ پولین استاتیکی می‌شود و همچنین خیز استاتیکی مرکز صفحه را کمی کاهش می‌دهد. به خاطر این که لحاظ کردن اثرات سطحی باعث افزایش سفتی خمشی نانوصفحه می‌شود. باید دقت کنیم که افزایش یا کاهش ولتاژ پولین به علامت τ^s بستگی دارد، چون در اینجا تنش پسماند سطحی کششی و علامت τ^s مثبت بود، لحاظ کردن اثرات سطح باعث افزایش مقدار ولتاژ پولین استاتیکی شد. اگر تنش پسماند سطحی فشاری و علامت τ^s منفی بود، اثرات سطح باعث کاهش مقدار ولتاژ پولین استاتیکی شد. شکل ۴ تاثیر لحاظ کردن نیروی کز میر بر ولتاژ پولین استاتیکی نانو صفحه را نشان می‌دهد. با توجه به شکل می‌توان مشاهده کرد که لحاظ کردن اثر نیروی کز میر باعث کاهش ولتاژ پولین نانوصفحه می‌شود. باید توجه کنیم که نیروی کز میر از اندرکنش بین مولکولی نانو صفحه و الکتروود صلب ناشی می‌

محاسبه شده است. برای اعتباردهی نتایج عددی ولتاژ پولین استاتیکی محاسبه شده را با نتایج راباک و پور سولا [۴۲] و نتایج اوستربرگ [۴۳] مقایسه شده است. جدول ۳ تطابق مناسب نتایج عددی به دست آمده را با نتایج عددی آزمایشگاهی نشان می‌دهد.

جدول ۱- داده‌های استفاده شده در محاسبات [۴۰, ۴۱].

پارامتر	مقدار
شعاع نانوصفحه دایره‌ای، $R_0 (nm)$	150
فاصله اولیه بین نانوصفحه و الکتروود صلب، $g_0 (nm)$	15
ضخامت نانوصفحه، $h (nm)$	5
مدول یانگ نانوصفحه، $E (GPa)$	68/5
چگالی نانوصفحه، $\rho_p (Kg/m^3)$	2700
ضریب پواسون، ν	0/3
مدول الاستیک سطحی، $E^s (N/m)$	-6/090
تنش کششی پسماند سطحی، $\tau^s (N/m)$	0/910
چگالی سطحی، $\rho^s (kg/m^2)$	$0/546 \times 10^{-6}$
ویسکوزیته دینامیکی سیال، $\mu (kg/m.s)$	$1/849 \times 10^5$
چگالی سیال، $\rho_f (Kg/m^3)$	1/184

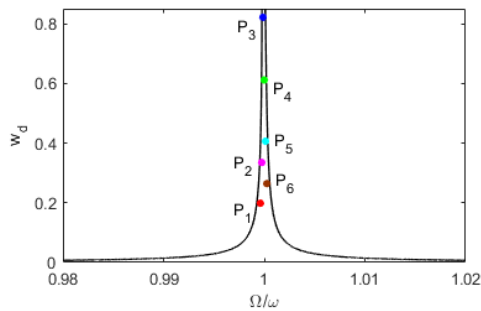
جدول ۲- اعتبار دهی حل عددی.

مقدار گام ولتاژ اعمالی (V)	0/001	0/005	0/01	0/05	ولتاژ Pull-in استاتیکی (V)
نتایج برای N = 1	306/3 7	306/3 8	306/4 0	306/5 5	
نتایج برای N = 2	318/9 3	318/9 4	318/9 6	319/1 5	
نتایج برای N = 3	316/7 0	316/7 1	316/7 3	316/9	

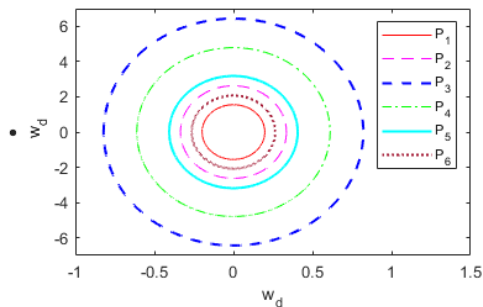
جدول ۳- مقایسه‌ی نتایج عددی و آزمایشگاهی.

مقدار گام ولتاژ اعمالی (V)	0/001	0/005	0/01	0/05	درصد خطا (%) در مقایسه با نتایج راباک و پورسولا [۴۲] (311.6 V)
اوستربرگ [۴۳] (314 V)	0/86	0/86	0/86	0/92	

Ω در اطراف فرکانس اصلی ω سیستم خطی تغییر می‌کند. برای اعتباردهی نتایج حل دینامیکی، نتایج بدست آمده از روش مقیاس‌های زمانی چند گانه با نتایج روش شویتینگ مقایسه شده است. در شکل ۵ دامنه پاسخ فرکانسی سیستم برای $V_{ac} = 0.02 V$, $\alpha_c = \alpha_s = l = 0$, $R_o = 100 nm$ با استفاده از روش مقیاس‌های چند گانه رسم شده است و برای شش نقطه مختلف دامنه پاسخ نشان داده شده با استفاده از روش شویتینگ هم محاسبه شده و بر روی نمودار نشان داده شده است. دیگرام فازی پاسخ‌های روش شویتینگ در نقطه‌های P_1 تا P_6 در شکل ۶ رسم شده است. با توجه به شکل ۵ مطابقت خوبی بین نتایج روش مقیاس‌های چند گانه و روش شویتینگ مشاهده می‌شود.

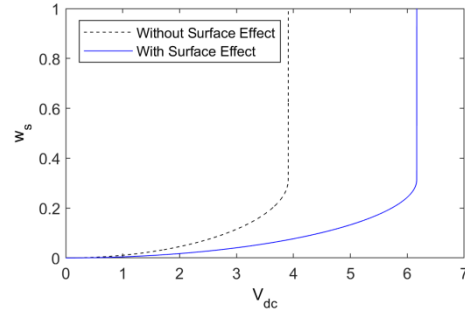


شکل ۵- مقایسه نتایج روش مقیاس‌های چندگانه و روش شویتینگ.

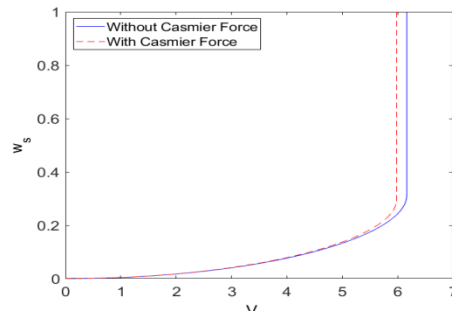


شکل ۶- دیگرام فازی پاسخ سیستم در نقاط مشخص شده. در شکل ۷ اثر پارامتر مقیاس طول روی رفتار رزونانس اصلی نانو صفحه بررسی شده است ($\rho^s = 0$, $D^s = \alpha_s = \alpha_c$). نتایج بدست آمده از تئوری تنش کوپل سازگار با نتایج تئوری کلاسیک ($l = 0$) مقایسه شده است. با توجه شکل می‌توان متوجه شد که افزایش مقدار پارامتر مقیاس طول، دامنه حداکثر پاسخ سیستم را کاهش می‌دهد و فرکانس رزونانس غیر خطی آن را افزایش می‌دهد.

شود و با افزایش فاصله اولیه بین آنها تاثیر نیروی کز میر کاهش پیدا می‌کند.



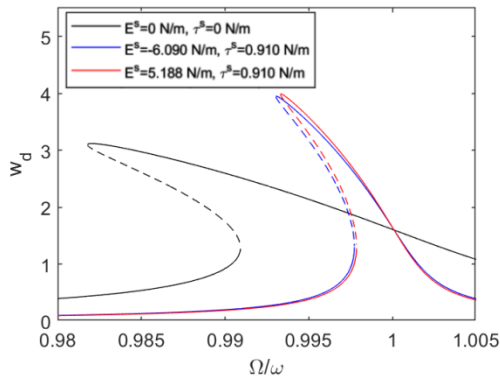
شکل ۳- تاثیر لحاظ کردن اثرات سطح بر روی مقدار ولتاژ پولین استاتیکی نانوصفحه دایره‌ای.



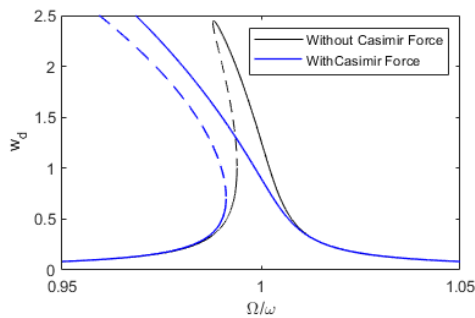
شکل ۴- تاثیر لحاظ کردن اثرات نیروی کز میر بر ولتاژ پولین استاتیکی نانوصفحه دایره‌ای.

۵-۲- پاسخ رزونانس اصلی سیستم

نتایج روش اغتشاشات برای ضرایب دمپینگ کوچک، دامنه کوچک ولتاژ هارمونیک و دامنه ارتعاش کوچک حول حالت تعادل استاتیکی صادق هستند. روش مقیاس‌های چندگانه برای استخراج دامنه پاسخ ماندگار سیستم (برای ارتعاشات با دامنه کوتاه) استفاده شده است؛ بنابراین نتایج بدست آمده برای خیزهای کوچکتر معتبر خواهند بود [۴۴]. در همه شکل‌های این بخش خط‌های ممتد نشان دهنده پاسخ‌های پایدار و خط چین‌ها نشان دهنده پاسخ‌های ناپایدار هستند. در مرحله مدلسازی به خاطر تقارن محوری و صفحه و بارگذاری الکترواستاتیک فرض شد که مد اول مد غالب باشد. در این قسمت اثر پارامترهای مختلفی مانند ولتاژ پایه V_{dc} ، دامنه ولتاژ V_{ac} و ابعاد هندسی بر روی رفتار رزونانس اصلی نانو صفحه از طریق شبیه سازی عددی بررسی شده است. به منظور مطالعه پاسخ رزونانس اصلی سیستم فرکانس تحریک



شکل ۸- تاثیر لحاظ کردن اثرات سطح بر روی پاسخ رزونانس اصلی نانوصفحه دایره‌ای.

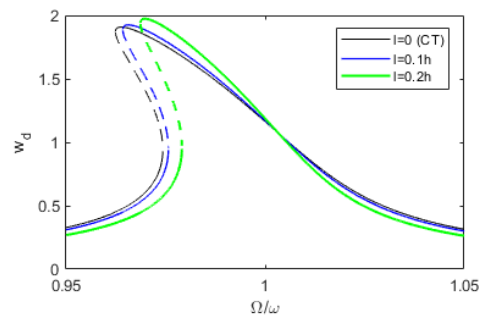


شکل ۹- تاثیر لحاظ کردن نیروی کز میر بر روی پاسخ فرکانسی رزونانس اصلی برای $V_{ac}=0.1V$ و $V_{dc}=3.5V$.

۶- نتیجه گیری

در این مقاله پاسخ رزونانس اصلی یک نانوصفحه دایره‌ای تحت تحریک غیرخطی الکترواستاتیک بررسی شده است. برای در نظر گرفتن اثرات اندازه و سطح به ترتیب از تئوری تنش کوپل سازگار و تئوری سطح گورتین-مورداک استفاده شده است. معادلات حاکم بر مساله با استفاده از روش همپلتون استخراج شده است. برای استخراج پاسخ فرکانس رزونانسی سیستم از روش مقیاس‌های چندگانه استفاده شد. نانوصفحه توسط ولتاژ پایه خم می‌شود و سپس توسط ولتاژ متناوب تحریک می‌شود تا حول حالت خم شده نوسان کند. نتایج بدست آمده نشان داد که لحاظ کردن اثرات اندازه باعث سخت‌تر شدن نانوصفحه و افزایش فرکانس رزونانس غیرخطی آن می‌شود و تحریک الکترواستاتیک و نیروی کز میر اثر نرم‌شوندگی دارند، در حالی که اثرات سطحی بسته به خواص

لحاظ کردن اثرات اندازه باعث سخت‌تر شدن سیستم و افزایش شیب شاخه ناپایدار می‌شود. برای مدول الاستیک سطحی آلومینیوم مقادیر متفاوتی توسط گروه‌های تحقیقاتی مختلف گزارش شده است ($E^s = -6.090 \text{ N/m}$ [۴۰, ۴۱] و $E^s = 5.1882 \text{ N/m}$ [۴۵]). در شکل ۸ تاثیر لحاظ کردن اثرات سطحی بر روی رفتار رزونانس اصلی نانوصفحه بررسی شده و پاسخ رزونانس اصلی سیستم برای مقادیر مختلف مدول الاستیک سطحی رسم شده است ($V_{ac} = 0.1V$ ، $V_{dc} = 1V$ و $l = 0$). با توجه به شکل می‌توان متوجه شد که لحاظ کردن اثرات سطح باعث سخت‌تر شدن سیستم و افزایش فرکانس خطی آن می‌شود، اما باید توجه داشت که این نتیجه کلی نیست برای خواص مکانیکی و شرایط مرزی استفاده شده در این مقاله درست است. در شکل ۹ تاثیر لحاظ کردن نیروی کز میر بر روی نمودار پاسخ فرکانس رزونانس اصلی نانوصفحه بررسی شده است ($V_{dc} = 2V$ ، $V_{ac} = 0/1V$ و $l = 0/1h$). می‌توان مشاهده کرد که با لحاظ کردن نیروی کز میر باعث افزایش رفتار نرم‌شوندگی سیستم و همچنین کاهش فرکانس رزونانس غیرخطی آن می‌شود. در واقع افزایش رفتار نرم‌شوندگی فرکانس رزونانس غیرخطی را به سمت فرکانس‌های تحریک پایین‌تر انتقال می‌دهد. لازم به ذکر است که رفتار نیروی کز میر مانند نیروی الکترواستاتیک هست، چون هر دو نیرو بین نانوصفحه و الکتروود صلب به وجود می‌آید و نانوصفحه را به سمت الکتروود صلب می‌کشد، اثر این نیروها بر روی سیستم این هست که باعث کاهش سفتی معادل سیستم می‌شوند، هر دو نیرو اثر نرم‌شوندگی دارند و مقدار این نیروها با فاصله اولیه بین نانوصفحه و الکتروود نسبت عکس دارد.



شکل ۷- مقایسه نتایج تئوری کلاسیک و تئوری تنش کوپل سازگار.

- [13] Asghari M, Rahaeifard M, Kahrobaiyan M, and Ahmadian M, (2011) The modified couple stress functionally graded Timoshenko beam formulation. *Mater Design* 32(3): 1435-1443.
- [14] Jomehzadeh E, Noori H, and Saidi A, (2011) The size-dependent vibration analysis of micro-plates based on a modified couple stress theory. *Physica E Low Dimens Syst Nanostruct* 43(4): 877-883.
- [15] Ke L-L, Wang Y-S, Yang J, and Kitipornchai S, (2012) Free vibration of size-dependent Mindlin microplates based on the modified couple stress theory. *J Sound Vib* 331(1): 94-106.
- [16] Reddy J and Kim J, (2012) A nonlinear modified couple stress-based third-order theory of functionally graded plates. *Compos Struct* 94(3): 1128-1143.
- [17] Dingreville R, Qu J, and Cherkaoui M, (2005) Surface free energy and its effect on the elastic behavior of nano-sized particles, wires and films. *J Mech Phys Solids* 53(8): 1827-1854.
- [18] Gurtin M E and Murdoch A I, (1975) A continuum theory of elastic material surfaces. *Arch Ration Mech An* 57(4): 291-323.
- [19] Gurtin M E, ME G, and AI M, (1978) Surface stress in solids.
- [20] Ansari R and Sahmani S, (2011) Surface stress effects on the free vibration behavior of nanoplates. *Int J Eng Sci* 49(11): 1204-1215.
- [21] Wang K and Wang B, (2012) Effects of residual surface stress and surface elasticity on the nonlinear free vibration of nanoscale plates. *J Appl Phys* 112(1): 013520.
- [22] Ansari R, Gholami R, Faghih Shojaei M, Mohammadi V, and Sahmani S, (2013) Surface stress effect on the vibrational response of circular nanoplates with various edge supports. *J Appl Mech* 80(2).
- [23] Wang K and Wang B L, (2014) Influence of surface energy on the non-linear pull-in instability of nano-switches. *Int J Nonlin Mech* 59: 69-75.
- [24] Wang K, Wang B, and Zhang C, (2017) Surface energy and thermal stress effect on nonlinear vibration of electrostatically actuated circular micro-/nanoplates based on modified couple stress theory. *Acta Mech* 228(1): 129-140.
- [25] Hamidi B A, Hosseini S A, Hassannejad R, and مکانیکی سطح و ابعاد و شرایط مرزی مساله می تواند اثر سخت یا نرم شوندگی داشته باشد.
- ۷- مراجع:**
- [1] Lam D, Yang F, Chong A, Wang J, and Tong P, (2003) Experiments and theory in strain gradient elasticity. *J Mech Phys Solids* 51(8): 1477-1508.
- [2] Miller R E and Shenoy V B, (2000) Size-dependent elastic properties of nanosized structural elements. *Nanotechnology* 11(3): 139.
- [3] Arash B and Wang Q, (2012) A review on the application of nonlocal elastic models in modeling of carbon nanotubes and graphenes. *Comp Mater Sci* 51(1): 303-313.
- [4] Wang K, Wang B, and Kitamura T, (2016) A review on the application of modified continuum models in modeling and simulation of nanostructures. *Acta Mech Sinica* 32(1): 83-100.
- [5] Toupin R A, (1962) Elastic materials with couple-stresses. *Arch Ration Mech An* 11(1): 385-414.
- [6] Mindlin R and Tiersten H, (1962) Effects of couple-stresses in linear elasticity. *Arch Ration Mech An* 11(1): 415-448.
- [7] Koiter W, (1964) Couple-stresses in the theory of elasticity, I and II, *Prec. Roy. Netherlands Acad. Sci. B* 67.
- [8] Hadjesfandiari A R and Dargush G F, (2011) Couple stress theory for solids. *Int J Solids Struct* 48(18): 2496-2510.
- [9] Aghababaie Beni M, Ghazavi M-R, and Rezazadeh G, (2017) A study of fluid media and size effect on dynamic response of microplate. *Modares Mech Eng* 17(9): 153-164.
- [10] Akbari Alashti R and Abolghasemi A H, (2014) A size-dependent Bernoulli-Euler beam formulation based on a new model of couple stress theory. *Int J Eng* 27(6): 951-960.
- [11] Yang F, Chong A C M, Lam D C C, and Tong P, (2002) Couple stress based strain gradient theory for elasticity. *Int J of Solids Struct* 39(10): 2731-2743.
- [12] Park S and Gao X, (2006) Bernoulli-Euler beam model based on a modified couple stress theory. *J Micromech Microeng* 16(11): 2355.

- [35] Talebian S, Rezazadeh G, Fathalilou M, and Toosi B, (2010) Effect of temperature on pull-in voltage and natural frequency of an electrostatically actuated microplate. *Mechatronics* 20(6): 666-673.
- [36] Gies H and Klingmüller K, (2006) Casimir effect for curved geometries: Proximity-Force-Approximation validity limits. *Phys rev lett* 96(22): 220401.
- [37] Bao M and Yang H, (2007) Squeeze film air damping in MEMS. *Sens. Actuator A Phys* 136(1): 3-27.
- [38] Rezazadeh G, Tahmasebi A, and Zubstov M, (2006) Application of piezoelectric layers in electrostatic MEM actuators: controlling of pull-in voltage. *Microsyst technol* 12(12): 1163-1170.
- [39] Nayfeh A H and Mook D T, (1979) *Nonlinear oscillations*. Wiley, New York.
- [40] Kroeger F and Swenson C, (1977) Absolute linear thermal expansion measurements on copper and aluminum from 5 to 320 K. *J Appl Phys* 48(3): 853-864.
- [41] Al-Damook A, Summers J, Kapur N, and Thompson H, (2016) Effect of temperature-dependent air properties on the accuracy of numerical simulations of thermal airflows over pinned heat sinks. *Int Commun Heat Mass Transfer* 78:163-167.
- [42] Raback P and Pursula A, (2004) Finite Element Simulation of the Electro-Mechanical Pull-In Phenomenon, in *European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering, ECCOMAS: Jyväskylä, Finland*.
- [43] Osterberg P, (1995) *Electrostatically Actuated Microelectromechanical Test Structures for Material Property Measurement*, in Department of Electrical Engineering and Computer Science. MIT.
- [44] Caruntu D I, Martinez I, and Taylor K N, (2013) Voltage-amplitude response of alternating current near half natural frequency electrostatically actuated MEMS resonators. *Mech Res Commun* 52: 25-31.
- [45] Gheshlaghi B and Hasheminejad S M, (2011) Surface effects on nonlinear free vibration of nanobeams. *Compos B Eng* 42(4): 934-937.
- [26] Hosseini S H S and Ghadiri M, (2021) Nonlinear dynamics of fluid conveying double-walled nanotubes incorporating surface effect: A bifurcation analysis. *Appl Math Model* 92: 594-611.
- [27] Abdelrahman A A, Mohamed N A, and Eltaher M A, (2020) Static bending of perforated nanobeams including surface energy and microstructure effects. *Eng Comput*: 1-21.
- [28] Puers R and Lapadatu D, (1996) Electrostatic forces and their effects on capacitive mechanical sensors. *Sens Actuator A Phys* 56(3): 203-210.
- [29] Nguyen C-C, Katehi L P, and Rebeiz G M, (1998) Micromachined devices for wireless communications. *Proc IEEE* 86(8): 1756-1768.
- [30] Sarafraz A, Sahmani S, and Aghdam M M, (2019) Nonlinear secondary resonance of nanobeams under subharmonic and superharmonic excitations including surface free energy effects. *Appl Math Model* 66: 195-226.
- [31] Mamandi A and Mirzaei ghaleh M, (2020) Nonlinear Vibration of a Microbeam on a Winkler Foundation and Subjected to an Axial Load using Modified Couple Stress Theory. *J Solid Fluid Mech* 10(4): 181-194.
- [32] Sarafraz A, Sahmani S, and Aghdam M, (2020) Nonlinear primary resonance analysis of nanoshells including vibrational mode interactions based on the surface elasticity theory. *Appl Math Mech* 41(2): 233-260.
- [33] Sahmani S, Fattahi A, and Ahmed N, (2020) Surface elastic shell model for nonlinear primary resonant dynamics of FG porous nanoshells incorporating modal interactions. *Int J Mech Sci* 165: 105203.
- [34] Xie B, Sahmani S, Safaei B, and Xu B, (2021) Nonlinear secondary resonance of FG porous silicon nanobeams under periodic hard excitations based on surface elasticity theory. *Eng Comput* 37(2): 1611-1634.